

Содержание

Международная конференция Физика.СПб/2024	463
Фунтикова А.С., Можаров А.М., Масталиева В.А., Неплох В.В., Мухин И.С., Федоров В.В. Моделирование генерации второй гармоники в наночастицах Si	464
Афанасьев С.А., Зайцев В.А., Моисеев С.Г., Рожлейс И.А., Санников Д.Г., Тертышникова Г.В. Поверхностные плазмон-поляритоны в двустенных углеродных нанотрубках	467
Ваулин Н.В., Афоничева П.К., Лебедев Д.В., Букатин А.С., Мухин И.С., Евстарпов А.А. Детектирование единичных биомолекул с помощью твердотельного нанопорового SiN/Si-сенсора	471
Бессолов В.Н., Коненкова Е.В., Орлова Т.А., Сокура Л.А., Соломникова А.В., Шарофидинов Ш.Ш., Щеглов М.П. HVPE эпитаксия полуполярных AlN(10 $\bar{1}1$) слоев на темплайте AlN/Si(100)	474
Болотов В.В., Князев Е.В., Ивлев К.Е., Пономарева И.В., Стенькин Ю.А., Несов С.Н., Росликова Е.А. Применение оксида марганца для повышения селективности газочувствительных пленок SnO $_2$	478
Давыдов С.Ю., Давыдовская К.С., Козловский В.В., Лебедев А.А. Температурная зависимость скорости удаления носителей в 4H-SiC	482
Мурзаханов Ф.Ф., Мамин Г.В., Садовникова М.А., Шуртакова Д.В., Казарова О.П., Гафуров М.Р. Отрицательно заряженные азотно-вакансионные центры в кристалле карбида кремния 6H- 28 SiC	485
Середин Б.М., Попов В.П., Малибашев А.В., Степченко А.Д. Трансформация кольцевой зоны на основе алюминия при ее термомиграции в кремнии в направлении $\langle 100 \rangle$	489
Стрельчук А.М., Калинина Е.В., Кудояров М.Ф., Патрова М.Я. Облучение ионами аргона диодов Шоттки на основе 4H-SiC	493
Васильев Ю.Б. Исследование дираковских состояний в квантовых ямах HgTe/CdHgTe кристаллографической ориентации (001)	497
Мынбаева М.Г., Лебедев С.П., Мясоедов А.В., Приображенский С.Ю., Амельчук Д.Г. Взаимодействие карбида кремния с расплавом кремния, образующимся в условиях прямого срашивания эпитаксиальных структур 3C-SiC/Si с пластинами 6H-SiC	501
Электронные свойства полупроводников	
Адамов Р.Б., Винниченко М.Я., Харин Н.Ю., Караулов Д.А., Фирсов Д.А. Анизотропия поляризации межзонной фотолюминесценции в μ -InAs, индуцированная электрическим полем	505
Поверхность, границы раздела, тонкие пленки	
Федоренко Е.Д., Клевцов А.И., Титов А.И., Андреева В.Д., Шахмин А.Л., Карасев П.А., Печников А.И., Николаев В.И. Модификация приповерхностных слоев альфа оксида галлия при облучении сверхбольшими дозами ионов	513